# HIGH FREQUENCY DEVICE

Patent Number:

JP52075101

Publication date:

1977-06-23

Inventor(s):

NAKAI KAICHIRO; others: 01

Applicant(s):

**TOSHIBA CORP** 

Requested Patent:

JP52075101

Application Number: JP19760151953 19761220

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05K9/00; H04B15/00; H03H7/02; H01J23/14

EC Classification:

Equivalents:

JP1147240C, JP57017344B

# **Abstract**

PURPOSE:To protect high frequency leakage-proof inductor in magnetron by connecting air-core and core inductors combined in simple structure to power supply wire in series.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

#### **報** (B2) 許

昭57-17344

1 Int.Ci.8 H 01 J 23/14 H 03 H 7/01 識別記号

庁内整理番号 7735-5C 7439 - 5 J

**网**网公告 昭和57年(1982) 4月10日

発明の数 1

(全2頁)

1

図マグネトロン装置

到特 願 昭51-151953

顧 昭50(1975)5月27日 御出

(前実用新案出顧日援用 )

開 昭52-75101

43昭52(1977)6月23日

何発 明者 中井嘉一郎

川崎市幸区堀川町72番地東京芝浦

電気株式会社堀川工場内

79発 明 者 斉藤久男

> 川崎市幸区堀川町72番地東京芝浦 電気株式会社堀川工場内

願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

创代 理 人 弁理士 寓岡章 外1名

### の特許請求の範囲

勿出

1 マグネトロン管本体の陰極入力端子にフィル タを構成するコア形インダクタが接続されてなる 20 マグネトロン装置において、上記マグネトロン本 体の陰極入力端子とコア形インダクタとの間に空 芯のインダクタが接続されてなることを特徴とす るマグネトロン装置。

#### 発明の詳細な説明

この発明はマグネトロン装置の改良に関する。 近時、マイクロ波装置の一つとして置子レンジ が多用されているが、この電子レンジからの不要 輻射を防止するためには、使用しているマグネト ロン装置からの不要輻射を厳しく制限する必要が 30 タ13のフェライトコア17を図の左方に移動し ある。そして一般に不要輻射の周波数帯域は低周 波からマイクロ波に至る迄大きな周波数帯域を含 んでいる。そこで電子レンジにおいては従来第1 図に示すように雑音つまり不要輻射防止対策とし て、マグネトロン管本体11の両陰極入力端子に 35 てもよい。 つながれる陰極入力導線12にそれぞれインダク タ13及びコンデンサ14からなるフィルタ15

を接続している。このフィルタ14は陰極入力端 子、導線12とともにシールドボツクス16の内 部にとりつけられる。

2

ところで上記フィルタ15のインダクタ13は 5 第2図に示すように、電波吸収体であり比透磁率 の高いフェライトコア17の外間に例えばフォル マル銅線等の電線18が密接して巻回されてなる コア形インダクタである。ところが、マグネトロ ン管本体 1 1 の陰極端子には中心発振周波数であ 10 る2450MHzのマイクロ波エネルギーが大きな 勢力を占める高周波成分が伝わつて出てきて、導 線12を経てインダクタ13まで達する場合があ る。従つてその髙周波エネルギーが大きいときに はフェライトコア17がエネルギーを吸収して可 15 成り高温に達し、その結果電線18の絶縁被覆が 損焼して絶縁不良を起としたり、フェライトコア がクラックを生じたりするという欠点がある。

との発明は上記従来の欠点を除去する構造のマ グネトロン装置を提供することを目的とする。 以下、図面を参照してこの発明の実施例を詳細

に説明する。なお同一部分は同一符号であらわす。

この発明では不要輻射の発生源であるマグネト ロン管本体とコア形インダクタとの間に空芯のイ ンダクタを挿入接続してなる。すなわち、その要 25 部は第3図に示すようにマグネトロン管本体11 (第1図参照)の陰極入力端子とフィルタ15を 構成するコア形インダクタ13との間に、空芯コ イルのインダクタ19が挿入接続されている。と の実施例において空芯インダクタ19はインダク

また第4図に示すよりに空芯のインダクタ19 を別個につくつてコア形インダクタ13に接続し

て右側に数ターンの空芯部分ができるようにして

尚、空芯のインダクタ**19**を挿入する点以外は 従来と同様構造ゆえ、詳細な説明を省略する。

形成してある。

との発明のマグネトロン装置は上記説明及び図 示のように構成され、不要輻射発生源であるマグ ネトロン管本体と入力側フィルタのコア形インダ クタとの間に空芯のインダクタが挿入されている ので、動作時には入力端子がわに伝わつて出よう 5 不都合は解消される。 とするマイクロ波の大部分の電力が直接コア形ィ ンダクタに伝送され吸収されるのが抑制される。 つまりその一部は空芯インダクタによつて反射ま たは減衰される。この結果、コア形インダクタの フェライトコアの温度上昇が抑制される。そして 10 平面図である。 その手前に接続された空芯インダクタはフェライ トコアの如き高周波吸収性の高いコアがないため それ自体で発熱することは少なく、仮りに発熱し ても熱が蓄積することがほとんどないため焼損を

起としたくい。

以上のようにこの発明によれば、フィルタを構 成するコア形インダクタのコアがクラックを生じ たり、導線が焼損して絶縁不良を発生するなどの

## 図面の簡単な説明

第1図は従来構造を示す回路構成図、第2図は その要部平面図、第3図はこの発明の一実施例を 示す要部平面図、第4図は他の実施例を示す要部

11…マグネトロン管本体、12…入力導線、 13…コア形インダクタ、15…フイルタ、17 …コア、19…空芯インダクタ。

